



컴팩트 사이즈, 고전력 밀도, 고신뢰성을 제공하는 IR의 200V HVIC와 DirectFET

Greater Protection; 50% More Power Density In A Compact Footprint

Complete Solution for Low- and Mid-Voltage Applications

200 V Driver ICs

Part	Package	UVLO	Compliance	Typical Current	Input Logic	Additional Features
IRS2001PBF	DIP8	UVLO, VCC	RoHS & PBF	290 mA / 600 mA	HIN, LIN	Independent high & low side drive
IRS2001SPBF	SOIC8 Bulk					
IRS2001STRPBF	SOIC8 Tape & Reel					
IRS2003PBF	DIP8	UVLO, VCC	RoHS & PBF	290 mA / 600 mA	HIN, LIN/N	Deadtime
IRS2003SPBF	SOIC8 Bulk					
IRS2003STRPBF	SOIC8 Tape & Reel					
IRS2004PBF	DIP8	UVLO, VCC	RoHS & PBF	290 mA / 600 mA	IN, SD/N	SD Input & deadtime
IRS2004SPBF	SOIC8 Bulk					
IRS2004STRPBF	SOIC8 Tape & Reel					

IR의 200V 드라이버 IC와 고성능 DirectFET[®] MOSFET은 컴팩트한 Size에서 높은 신뢰성과 높은 파워 밀도를 제공해 줍니다.

IRS200x 특징

- 부트스트랩 파워 공급에 의한 High side gate drive 구동 능력
- Undervoltage lockout protection
- 3.3V, 5V, 15V 로직의 호환성
- 하프 브릿지 드라이버의 Shut-through 방지를 위한 Deadtime 내장
- 섀다운 기능을 가진 IRS2004(S)PBF
- 50V/ns의 dV/dt Immunity

DirectFET[®] MOSFETs

Part	Package	Polarity	VBRDSS (V)	$R_{DS(on)}$ 4.5 V Max. (m Ω)	$R_{DS(on)}$ 10 V Max. (m Ω)	I_D @ TC = 25 C (A)	Q_g Typ	Q_{gd} Typ	$R_{th(j-c)}$	Power Dissipation @ $T_c = 25 C (W)$
IRF6635	DirectFET	N	30	2.4	1.8	180	47.0	17.0	1.4	89
IRF6613	DirectFET	N	40	4.1	3.4	150	42.0	12.6	1.4	89
IRF6648	DirectFET	N	60		7.0	86	36.0	14.0	1.4	89
IRF6646	DirectFET	N	80		9.5	68	36.0	12.0	1.4	89

DirectFET[®] 특징

- Top side 냉각을 통한 Junction-Case 간의 매우 낮은 열저항 제공
- $R_{th(j-c)} = 1.4^{\circ}C/W$
- D-pak 에서 $1^{\circ}C/W$ 이하의 열저항 성능
- D-pak 보다 더 낮은 Die-free 패키지 저항 (DFPR)
- D-pak(2.39mm) 보다 낮은 0.7mm profile

DirectFET[®] is a registered trademark of International Rectifier Corporation

제품이나 기타 문의가 있으시면, 언제든지 www.irf-asia.com/contact 의 "Customer Relationship Management"에 남겨주시기 바랍니다.

International
IR Rectifier
THE POWER MANAGEMENT LEADER